

Кремниевый фотодетекторный чип 3.048 мм — техническое описание

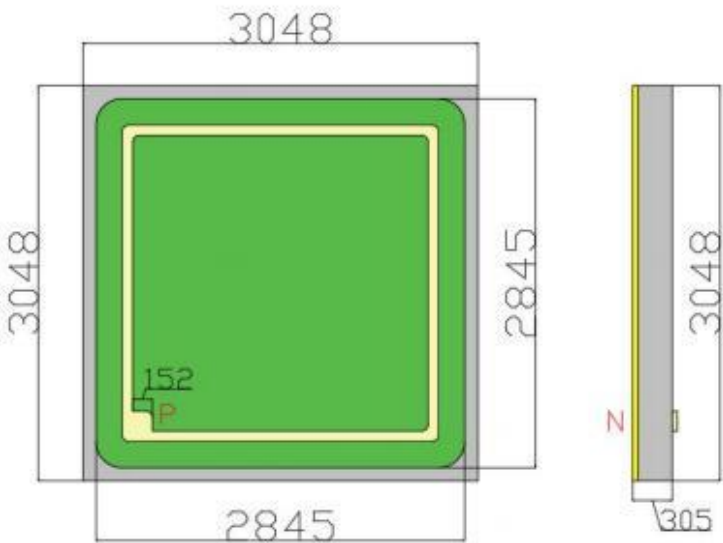
P/N : WS9E-01C

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — Au, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	2845±20 x 2845±20			мкм
Ширина чипа	3048			мкм
Длина чипа	3048			мкм
Высота чипа	285	305	325	мкм
Размер контактной площадки		152		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100µA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR=5V, f=1MHz		16		пФ